

关键指标

频率：2~4.2GHz

增益：24dB

1dB 压缩点输出功率：24dBm

电压/静态电流：+5V/180mA

芯片尺寸：1.75mm×1.25mm

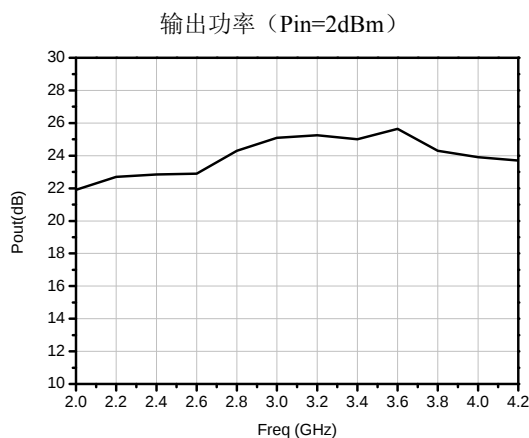
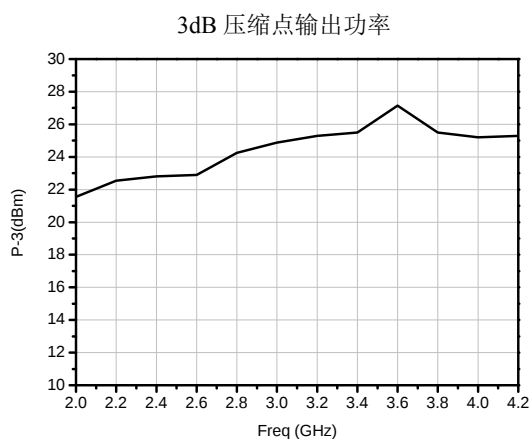
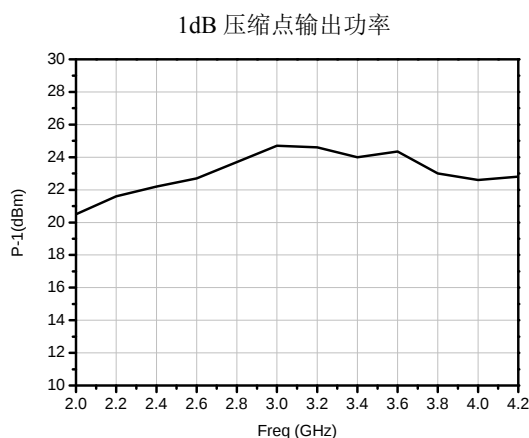
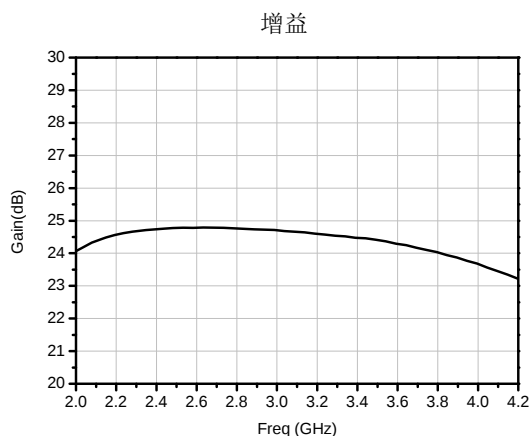
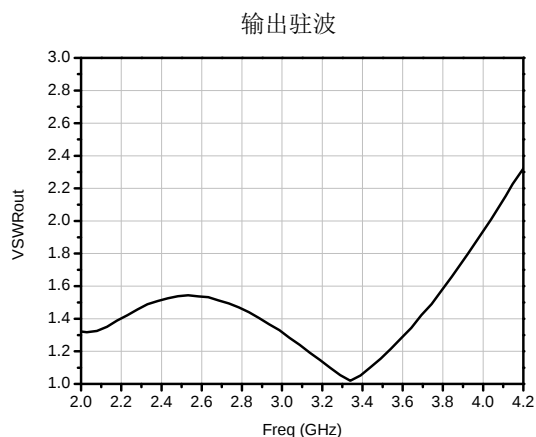
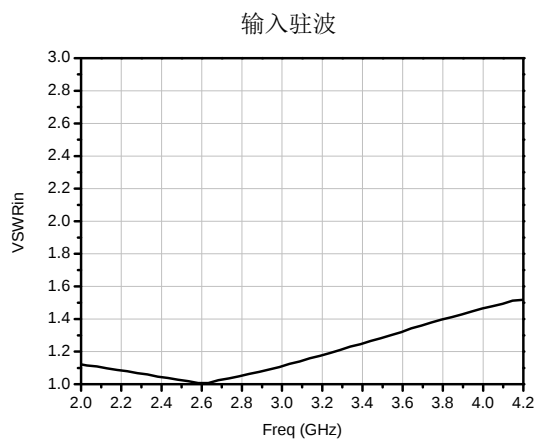
产品简介

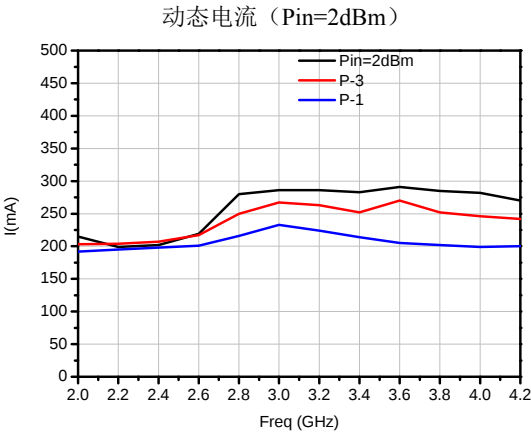
HG123F1 是一款中功率放大器芯片，采用 GaAs pHEMT 工艺制作，增益为 24dB，1dB 压缩点输出功率 24dBm，采用单电源+5V 供电，静态电流为 180mA，输入输出端均集成有隔直电容。

电性能 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=+5\text{V}$)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~4.2		
增益(dB)	-	24	-
增益平坦度(dB)	-	± 1	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.4	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	24	-
输出功率 (dBm)	-	24.5	-
静态电流 (mA)	-	180	-

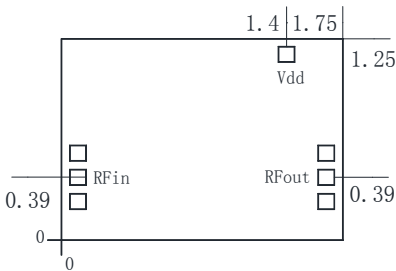
典型测试曲线



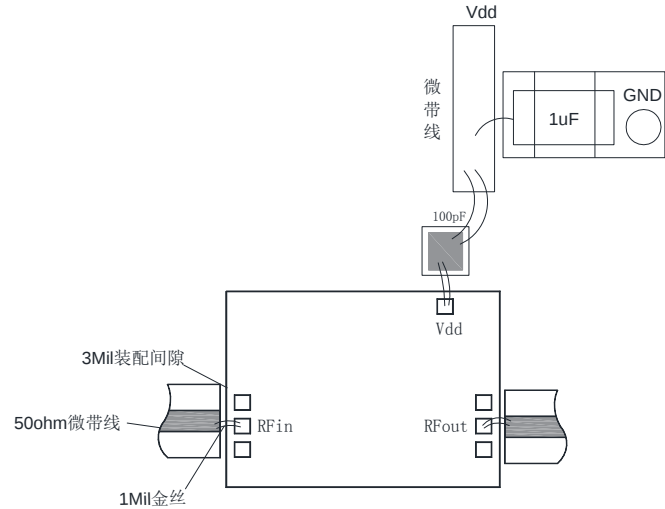


- 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

- 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
- GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
- 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
- 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm